
	<h2 style="color: red;">FDB047N10</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB047N10</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDB047N10.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 31574 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB047N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	31574 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB047N10CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15265pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	210nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 120A (Tc) 375W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDB047N10 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB047N10-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB047N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB047N10 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB050AN06AO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>	 <p>FDB045AN08_F085 FAIRCHILD FDB045AN08_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB045AN08AO_NL Fairchi FDB045AN08AO_NL Fairchi</p>	 <p>FDB045AN08AO FAIRCHI FDB045AN08AO FAIRCHI</p>
 <p>FDB045AN08AO-M FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p>	 <p>FDB060AN08AO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-263AB</p>	 <p>FDB047N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB050AN06AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>

FDB047N10 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB047N10 Semiconductor / ON Semiconductor	FDB047N10 Datenblatt	FDB047N10-Datenblätter	FDB047N10 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB047N10
FDB047N10 Electronic	FDB047N10-Komponenten	FDB047N10-Verteiler	FDB047N10-Bild	FDB047N10-Teil
FDB047N10 Preis	FDB047N10 Hersteller	FDB047N10 Bild	FDB047N10 Aktie	FDB047N10 Inventar
FDB047N10 Neu	FDB047N10 Original	FDB047N10 garantiert	FDB047N10 RFQ	FDB047N10 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited